



汕头华汕电子器件有限公司

A1

NPN SILICON TRANSISTOR

HA42

对应国外型号

MPSA42

**主要用途**

高压控制应用。(与 HA92 互补)

**极限值 (T<sub>a</sub>=25 )**

T <sub>stg</sub>	——贮存温度.....	-55~150
T <sub>j</sub>	——结温.....	150
P <sub>C</sub>	——集电极耗散功率.....	625mW
V <sub>CBO</sub>	——集电极—基极电压.....	300V
V <sub>CEO</sub>	——集电极—发射极电压.....	300V
V <sub>EBO</sub>	——发射极—基极电压.....	6V
I <sub>C</sub>	——集电极电流.....	500mA

**外形图及引脚排列**



**电参数 (T<sub>a</sub>=25 )**

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV <sub>CBO</sub>	集电极—基极击穿电压	300			V	I <sub>C</sub> =100 μA, I <sub>E</sub> =0
BV <sub>CEO</sub>	集电极—发射极击穿电压	300			V	I <sub>C</sub> =1mA, I <sub>B</sub> =0
BV <sub>EBO</sub>	发射极—基极击穿电压	6			V	I <sub>E</sub> =100 μA, I <sub>C</sub> =0
I <sub>CB0</sub>	集电极—基极截止电流			100	nA	V <sub>CB</sub> =200V, I <sub>E</sub> =0
I <sub>EB0</sub>	发射极—基极截止电流			100	nA	V <sub>EB</sub> =6V, I <sub>C</sub> =0
I <sub>CES</sub>	集电极—发射极截止电流			1	μA	V <sub>CE</sub> =300V, V <sub>BE</sub> =0
H <sub>FE</sub>	直流电流增益	25				V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =1mA
		40				V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =10mA
		40				V <sub>CE</sub> =10V, I <sub>C</sub> =30mA
V <sub>CE(sat1)</sub>	集电极—发射极饱和电压			0.5	V	I <sub>C</sub> =20mA, I <sub>B</sub> =2mA
V <sub>CE(sat2)</sub>	集电极—发射极饱和电压			1.0	V	I <sub>C</sub> =60mA, I <sub>B</sub> =6mA
V <sub>BE(sat)</sub>	基极—发射极饱和电压			0.9	V	I <sub>C</sub> =20mA, I <sub>B</sub> =2mA
f <sub>T</sub>	特征频率	50			MHZ	V <sub>CE</sub> =20V, I <sub>C</sub> =10mA, f=100MHZ